

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(499KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中包含“方钴矿”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [糜建立](#)
- [赵新兵](#)
- [朱铁军](#)
- [曹高劭](#)

Te掺杂方钴矿 CoSb_3 的溶剂热合成及电学性能

糜建立, 赵新兵, 朱铁军, 曹高劭

浙江大学硅材料国家重点实验室, 杭州 310027

收稿日期 2006-9-10 修回日期 2006-10-25 网络版发布日期 2007-8-25 接受日期

摘要 以 CoCl_2 , SbCl_3 和Te粉为原料, NaBH_4 为还原剂, 用溶剂热方法合成了Te掺杂方钴矿 $\text{CoSb}_{3-x}\text{Te}_x$ ($x=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4$)纳米粉末。研究发现, Te含量较高的样品($x\geq 0.2$)有明显的 CoTe_2 等杂相存在。 CoSb_3 -

xTe_x 合成粉末的粒径大小在40nm左右, 热压后晶粒发生长大, 平均晶粒尺寸约为300nm。

电学性能测试表明Te掺杂方钴矿 $\text{CoSb}_{3-x}\text{Te}_x$ 的导电类型为n型, Seebeck系数的绝对值随着Te含量的增加而变小, 电导率随着Te含量的增加而增大。在测试温度范围内, $\text{CoSb}_{2.8}\text{Te}_{0.2}$ 具有最高的功率因子, 在773K温度下达到 $2.3\times 10^3 \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-2}$ 。

关键词 [方钴矿](#) [溶剂热合成](#) [Te掺杂 \$\text{CoSb}_3\$](#) [热电材料](#)

分类号

[0482, TN37](#)

Solvothermal Synthesis and Electrical Transport Properties of Te-doped CoSb_3 Skutterudites

MI Jian-Li, ZHAO Xin-Bing, ZHU Tie-Jun, CAO Gao-Shao

State Key Laboratory of Silicon Materials, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

Abstract Nanosized Te-doped skutterudites $\text{CoSb}_{3-x}\text{Te}_x$ ($x=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4$) were prepared by a solvothermal method using CoCl_2 , SbCl_3 and pure telluride powder as precursors and NaBH_4 as reductant. It is found that trace of other impurity phases such as CoTe_2 are coexisted for $x\geq 0.2$. The size of synthesized $\text{CoSb}_{3-x}\text{Te}_x$ powders is about 40nm, and the grains are grown up to an average size of about 300nm after hot-pressing. Transport properties measurements indicate that the Te-doped $\text{CoSb}_{3-x}\text{Te}_x$ have n-type conduction. As the Te fraction increases, the values of electrical conductivity increase, while the absolute Seebeck coefficient values decrease. A maximum power factor of $2.3\times 10^{-3} \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-2}$ is obtained at 773K for $\text{CoSb}_{2.8}\text{Te}_{0.2}$.

Key words [skutterudite](#) [solvothermal synthesis](#) [Te-doped \$\text{CoSb}_3\$](#) [thermoelectric materials](#)

DOI:

通讯作者 赵新兵 zhaoxb@zju.edu.cn